

# InGaAs系高利得量子井戸半導体レーザーの開発及び評価測定

小松原 望

平成31年1月4日

## 概 要

論文の要旨を記入

## 目 次

## 図 目 次

## 表 目 次

# 第1章 序論

## 1.1 研究背景

### 1.1.1 半導体レーザーからの超短光パルス発生

#### 様々な短パルス発生法

半導体レーザーは産業的に広く普及している発光素子である。小型化可能、大量生産可能、熱や振動(安定性)に強いことなどが主な理由である。さらに半導体から直接ピコ秒程度の超短光パルスを発生させる技術も研究が盛んに行われており、産業への応用が期待されている。

半導体から短パルスを発生させる方法として従来行われてきた方法が主に3つある。モード同期法、Qスイッチ法、利得スイッチ法である。モード同期法は個体レーザーでも用いられておりフーリエ限界に近いパルス幅を生成できる反面パルスの繰り返し周期が固定されてしまうという特徴を持つ。一方Qスイッチング法は過飽和吸収帯を用いるなどしてQ値を瞬間的に増大させることで高エネルギーの光パルスを得ることができる。利得スイッチングは複雑な構造を必要とせず、全ての半導体レーザーで実現が可能な技術であり実用性に秀でている。レーザー加工などの技術的応用においては繰り返し可変であることや様々な種類の光源を試すことができるという利点があるため、本研究では利得スイッチング法に着目した。

#### 利得スイッチング法

利得スイッチングはこの右下の図は過去40年間に行われてきた利得スイッチングのパルス幅をプロットしたものです。赤が光励起、青が電流注入を表しています。今回意図しているのは電流注入であるため、青を見てみると最短でも5psであることがわかります。この限界に挑戦したいというのがモチベーションです。[伊藤さん論文]

#### 利得スイッチング光パルスの短パルス化

まずは利得スイッチングのメカニズムについて説明いたします。利得スイッチングとは半導体にns以下の時間内に強く励起することで半導体内にできたキャリアが一気に放出される現象です。右の図は上から順に励起パルス、発光パルスおよび利得の時間発展の計算結果を表したものです。電流注入に関する青いプロットを見ていただくと長い励起パルスを引火すると、利得が上がっていき、発振閾値を超えたところでキャリアを使って20ps程度の短いパルスが出てきます。

ではどのような半導体ならば短いパルスが出てくるのかという疑問に達しますがこのような先行研究がなされています。この2つの連立方程式はそれぞれキャリアとフォトンの時間変位を記述するレート方程式です。先ほどのシミュレーションも同等の式に従って計算されたものです。この研究の中ではキャリアのフォトンへの変換効率に寄与する $g$ というファクターが高いほど発生パルスが短くなるということが示唆され、実験的に示されました。

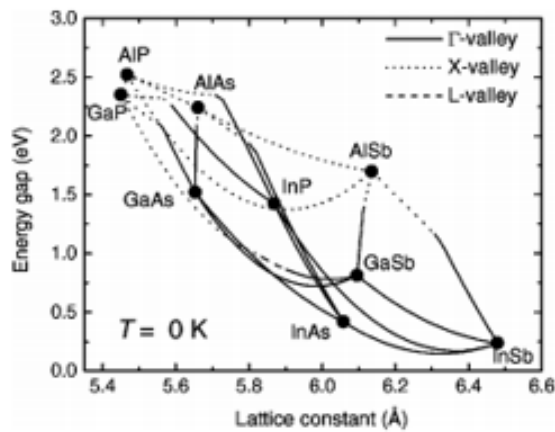


FIG. 3. Lowest forbidden gap as a function of lattice constant for non-nitride III-V compound semiconductors (points) and their random ternary alloys (lines) at zero temperature. The materials with  $\Gamma$ -,  $X$ -, and  $L$ -valley gaps are indicated by solid, dotted, and dashed lines, respectively.

## Band parameters for III-V compound semiconductors and their alloys

図 1.1: 格子定数

### 1.1.2 InGaAs 高利得材料

@歪み補償 InGaAs を用いる理由 InGaAs

## 1.2 本研究の目的

電流注入により短いパルスを達成すること？新しい構造を作ったからそれを図ること？

## 第2章 試料構造と測定方法

### 2.1 はじめに

本研究では InGaAs/GaAs 多重量子井戸・ファブリーペロー型の半導体レーザーをデザインした。本章では 2.2 節でそのエピ構造とデバイス化のためのプロセスについて、2.3 節で測定手法について述べる。

### 2.2 試料作製

本研究では活性層に InGaAs/GaAs 多重量子井戸を持つウエハをデザインした。本 2.2 節ではデザインと測定するためのデバイス化について述べる。ウエハの結晶成長は NTT-AT および台湾の会社？に依頼した。結晶成長また後述のリッジ加工プロセスやコンタクトメタル蒸着は NTT-AT に依頼した。

#### 2.2.1 試料構造

まずはエピウエハ構造について述べる。量子井戸の周期は 3 周期と 10 周期の 2 種類である。それぞれのエピ構造を図??に示す。n タイプ GaAs 基板の上にバッファ層が丸々 nm, その後 n-AlGaS がどうたらこうたら SCH 層がどうたらこうたら。バンドギャップの図があると良い屈折率とかも



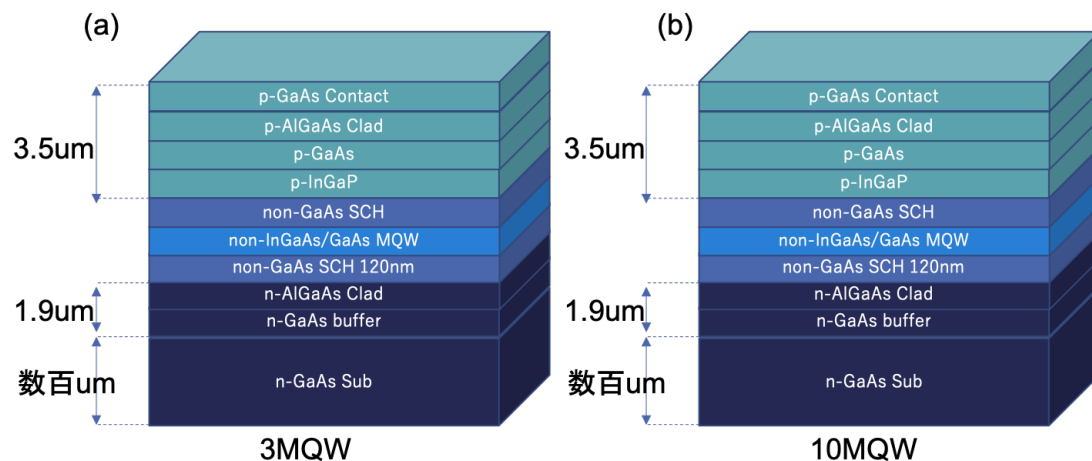


図 2.1: エピウエハ構造

### 2.2.2 ブロードコンタクトレーザー

結晶成長の後 n 側と p 側にコンタクト金属の蒸着を行った。p 側の原子はなにに、n 側はなににである。劈開面は 001? とかなんとかブロードコンタクトレーザーとは光導波路を形成せずバー(棒)のままのレーザーである。プロセスを簡略化することで早く測定を行うことを目的とした。ウエハの評価測定のために用いた。図 2.2 に模式図を示す。図 2.2 の上から下に向かって電流が流れ、活性層でキャリアの再結合が起き発光が起こる。また図の手前と奥の劈開面でファブリーペロー共振器を形成しており、反転分布となっているときに光がそこを往復することで誘導放出が起き発振し、紙面の手前と奥方向に(軸を用意した方がいいか?) この文章だと絵をバーっぽくした方がいいか? 共振器長は 500, 1000, 2000um の 3 種類を作製した。また電極パッド幅は 3, 5, 10, 30, 50, 100, 300um の 6 種類を作製した。

### 2.2.3 リッジ導波路型レーザー

次にリッジ導波路型レーザーについて述べる。その模式図を図 2.4 に示す。エピウエハ作製後 p 側クラッド層を活性層直上までエッチングすることで光導波路を形成している。横方向の光閉じ込めが大きくなるため、キャリアと光の重なりが大きくなるため利得を大きく? することができる。参考文献欲しい。最終的に利得スイッチング動作を試みるデバイスである。共振器長は 100, 200, 300, 400, 500, 1000um, リッジ幅は 1.5um, 2.5um のものを作製した。

### 2.2.4 マウント (ダイボンディング??)

作製したブロードコンタクトレーザーおよびリッジ導波路型レーザーを電流注入実験を行うためにマウントを行なった。それぞれ図に示す。

レーザーバーは AlN 基板に AnSn メッキを施してあるサブマウント (... 社製) にダイボンディングした。ブロードコンタクトレーザーはダイボンディングしてなかったっけ? そういえばこの状態で試料上面の電極をプローバー (先端の径... 程度の金属の針) でさわって、電流を流した。一本のバーに 5 個程度の素子があるので測定が終わったら次々とプローバーの触る箇所をかえていけば速やかに測定を続けることができる。

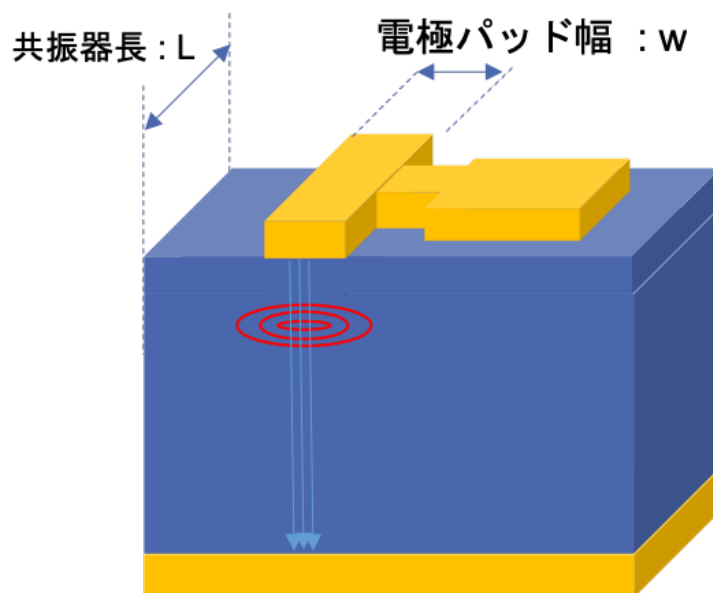


図 2.2: ブロードコンタクレザー

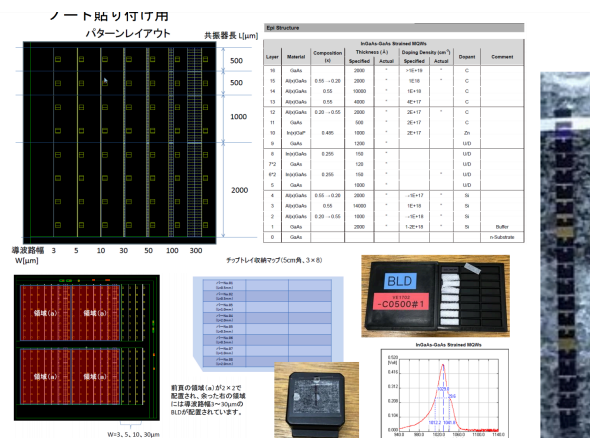


図 2.3: ブロードコンタクレザーめも

一方リッジ導波路型レーザーの一部は利得スイッチング動作実験を行うために高速応答が期待できるようにマウントした。Transistor Outline パッケージと呼ばれる缶状の金属にマウントを行った。.... 社製の CAN を用いた。その際レーザーバーをさらに分割し 1 つ 1 つの素子に分離した。分離した素子を AnSn 共晶材あるいはエポキシを用いて CAN にダイボンディングし、金線をワイヤーボンディングマシンで配線した。

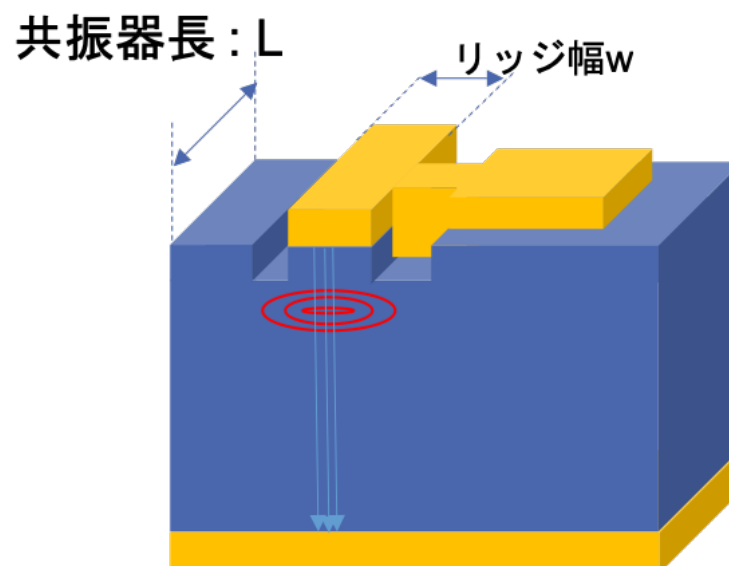


図 2.4: リッジ導波路型レーザー

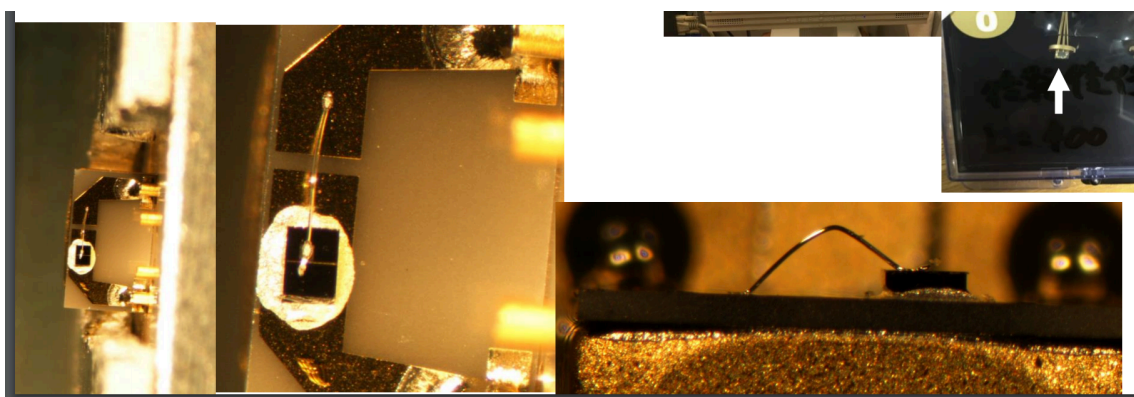


図 2.5: 測定デバイス外観

## 2.3 測定方法

本研究では主に2つの実験を行った。1つはエピウエハの品質を評価するための定常電流を印加する実験である。もう一つは利得スイッチング動作を起こすための短い電気パルスを印加する実験である。それぞれについて節ごとに述べる。

### 2.3.1 定常電流注入による測定実験

まずエピウエハの品質を調べるために定常電流を注入する実験である。発振閾値電流や発振時の発光効率すなわち外部量子効率などの基本的な物性パラメータを見積もることができる。実験系を図2.6に示す。パルスジェネレータから数 $\mu\text{s}$ パルスを数 $\text{ms}$ 繰り返し周期で発生させ試料に注入する。ここでマイクロ秒程度のパルスは試料の中での発光過程やその他の物理現象の時間オーダーに対して十分長く、定常電流とみなすことができる。DC電流では熱の影響が大きくなってしまい試料が壊れてしまう恐れがあるため。Duty比(パルス幅と繰り返し周期の比)を1:1000程度に設定して実験を行った。試料からの発光強度を光パワーメータで測定した。また、回路に試料と直列に抵抗( $22.4\Omega$ )を入れ、そこにかかる電圧をモニターすることで流れる電流をそくていした。また回路全体の電圧と抵抗にかかる電圧の差をとることで試料にかかる電圧を算出した。

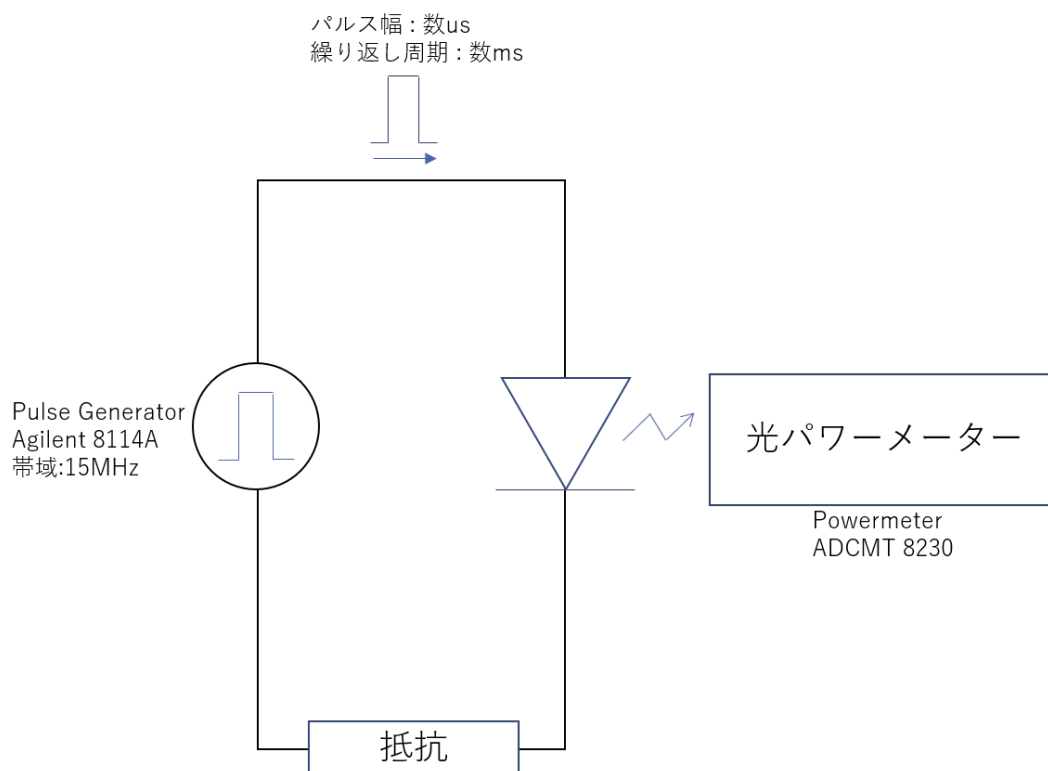


図 2.6: IL 実験系回路図

ここで用いた機材を 2.1 に示す。

表 2.1: 定常電流印加実験に用いた機材

機材	型番
Pulse Generator	Agilent 8114A
Power Meter	ADCMT 8230
Oscilloscope	-

### 2.3.2 電流注入利得スイッチング実験

ナノ秒程度の短いパルス電圧を印加することで利得スイッチング動作を起こした。その実験系の回路図を図??に示す。電気パルスがパルスジェネレータから同軸ケーブルを介して試料へ印加される。パルスジェネレータで生成された電圧パルスは可変抵抗、RF アンプで増幅されデバイスへと印可される。試料からの発光は対物レンズでコリメートされ、非球面レンズで光ファイバーに集光される。その後フォトダイオードで検出しその電圧を高速サンプリングオシロスコープでモニタすることで光の時間波形を測定した。この実験で用いた機材を??にまとめた。

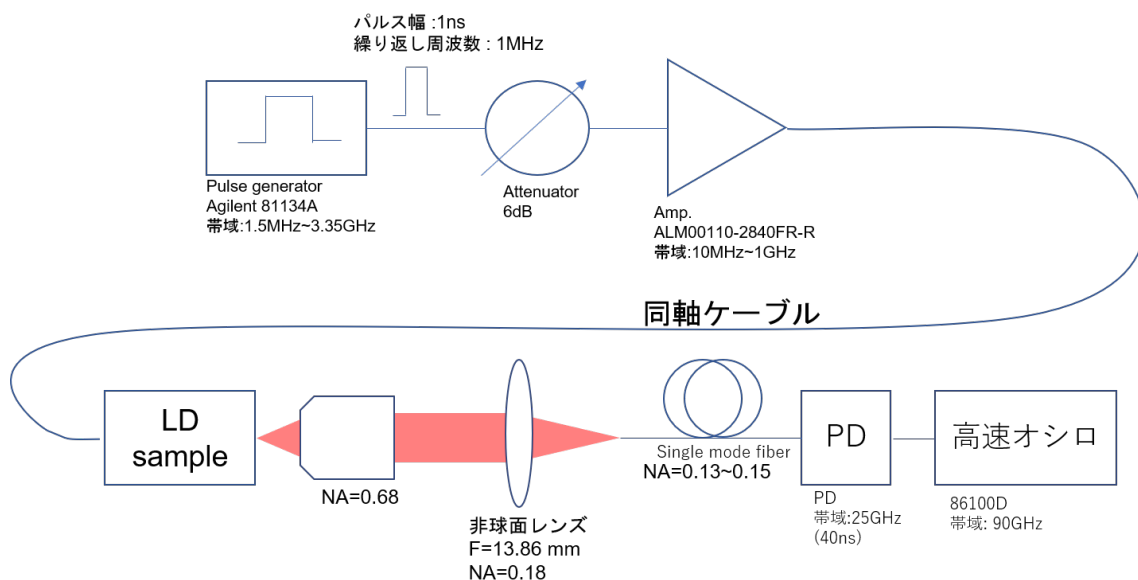


図 2.7: GS 実験系

表 2.2: 利得スイッチング実験に用いた機材

機材	型番	帯域
Pulse Generator	Agilent 81143A	1.5MHz~ 3.35GHz
Attenuator	埋める	埋める
RF Amp	ALM00110-2840FR-R	10MHz ~ 1GHz
PD	埋める	25GHz
Oscilloscope	86100D	90GHz

## 第3章 実験結果

本章では3.1節ではブロードコンタクトレーザー、3.2節ではリッジ導波路型レーザーへの電流注入実験についての実験結果を報告する。

### 3.1 ブロードコンタクトレーザー試料に関する測定結果

まず、ブロードコンタクトレーザーへ定常電流を流して測定を行った。様々な共振器長、電極パッド幅の試料に対して実験を行うことでウエハの基本的な物性パラメータを見積もることが目的である。

本体であればDC電流を印可することで定常発振させることが望ましい。しかし試料への熱の影響が無視できないほど大きくなってしまうため、本研究ではDC電流の代わりにマイクロ秒程度パルス電圧を印可した。マイクロ秒は半導体素子の中が定常状態になるには十分長い本研究ではD電流は...ms秒周期、... $\mu$ sのパルス電流を流した。 $\mu$ s程度の電流は試料にとっては定常と見なされる。まずは定常状態の測定。発振閾値電流を測定することに加えて、発振時の印可電流の増分したいする光出力の増大から発光量子効率を見積もることが目的である。様々なパラメータを測定する。ウエハの構造ごとに節を分けている。

#### 3.1.1 3QW

図??に3周期量子井戸レーザーのILカーブおよびIVカーブの結果を示す。代表としてパッド幅を $w=50\mu\text{m}$ の物をプロットした。片面からの発光強度である。デューティーひは1:2000である。1 $\mu\text{s}$ ,2ms各デバイスにおいて出力強度が電流値を上げてくと増加していくことがわかる。またそれぞれのデバイスにおいて発信閾値を持つことが見て取れる。

ILカーブの発振時に対して直線フィッティングをおこないx切片を閾値電流とした。次に様々

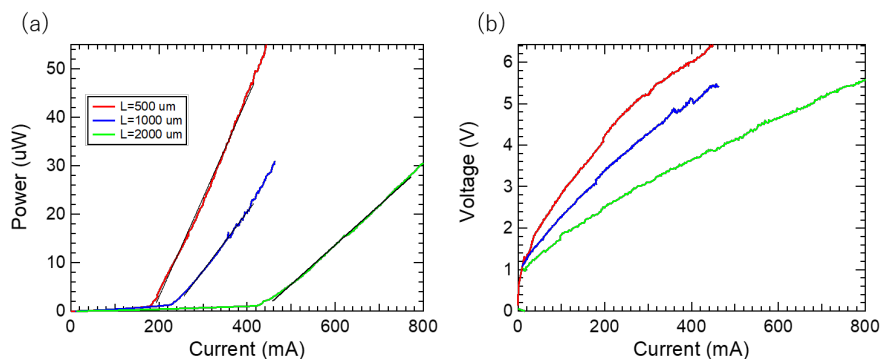


図 3.1: 3MQW の IL 結果

なパッド幅に対して実験を行いフィッティングを行なったのでその結果を図??に示す。パッド幅が大きくなるにしたがって閾値電流が線形に増大することがわかる。一方すろーぶは。。。。。

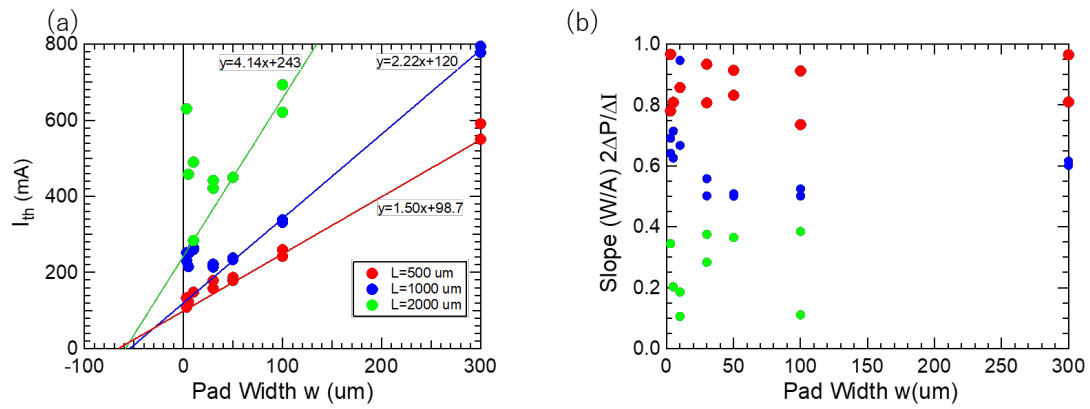


図 3.2: 3MQW の閾値電流



### 3.1.2 10QW

次に10周期量子井戸ブロードコンタクトレーザについての結果を示す。IL カーブおよびIVカーブを $w = 50$ をだいひょうとしてしめす。いろいろは共振器ながさのちがいをあらわす。それぞれについてははしんがかくにんできた。デューティー比は1対1000である。(2us 2ms 周期) またIL カーブの発振時の直線フィッティング結果から閾値電流  $I_{th}$  と傾き  $dP/dI$  をプロットした。

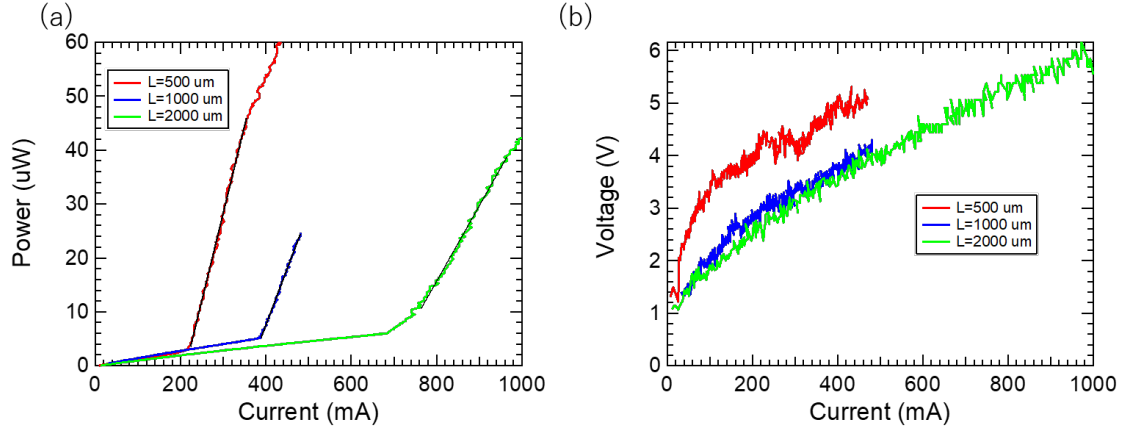


図 3.3: 10MQW の IL 結果

$dP/dI$  については d デューティー比を考慮してまた両端面からの発光を算出している。

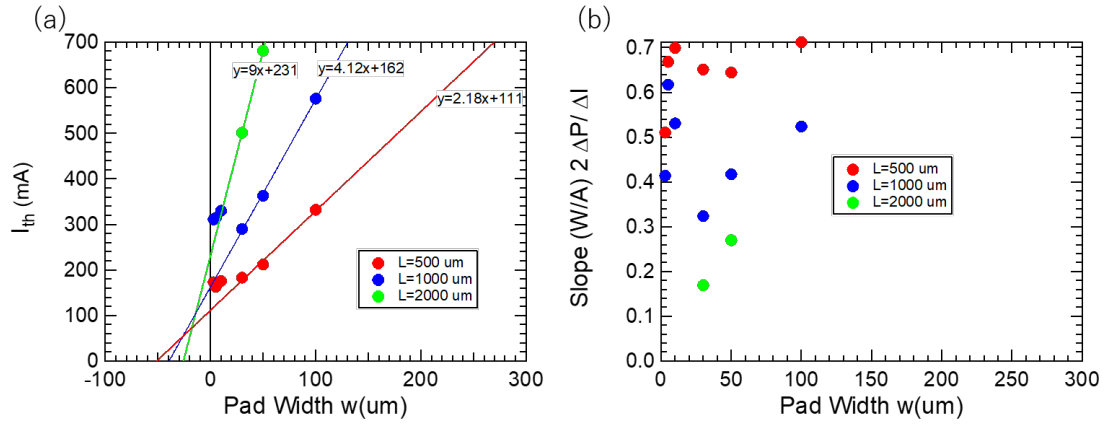


図 3.4: 10MQW の IL 結果

### 3.1.3 電流広がりに関する考察

レーザーの基本的な特性を知る上で閾値電流密度が大切なパラメータとなる。これを見積もるために先の節の結果からキャリアの広がりを見積もった。

本体閾値電流電流は電流を流す面積に比例して大きくなるはずであるが図を見るとそうになっておらず赤ペンを持っている。その x 切片を含めたパッド幅を有効的な幅と考えて閾値電流密度を算出した。まずは有効パッド幅を見積もった。図??と図??それぞれの (a) において  $I_{th}$  が線形に増加する領域をフィッティングした。そのフィッティング関数の x 切片の絶対値が実質的なパッド幅の増分である。その値を表に示した。

表 3.1: 3QW ブロードコンタクトレーザーの電流広がり		
共振器長 L (um)	パッド幅の増分 (電流の広がり) $w'$ (um)	
500	65.8	
1000	54.1	
2000	58.7	

表 3.2: 10QW ブロードコンタクトレーザーの電流広がり		
共振器長 L (um)	パッド幅の増分 (電流の広がり) $w'$ (um)	
500	51.1	
1000	39.5	
2000	25.7	

この表の値  $w'$  と閾値電流  $I_{th}$  (mA) から式 (??) を用いて 閾値電流密度  $J_{th}$  (kA/cm<sup>2</sup>) を算出した。

$$J_{th} = \frac{I_{th}}{(w + w')L} \quad (3.1)$$

その結果を示す。

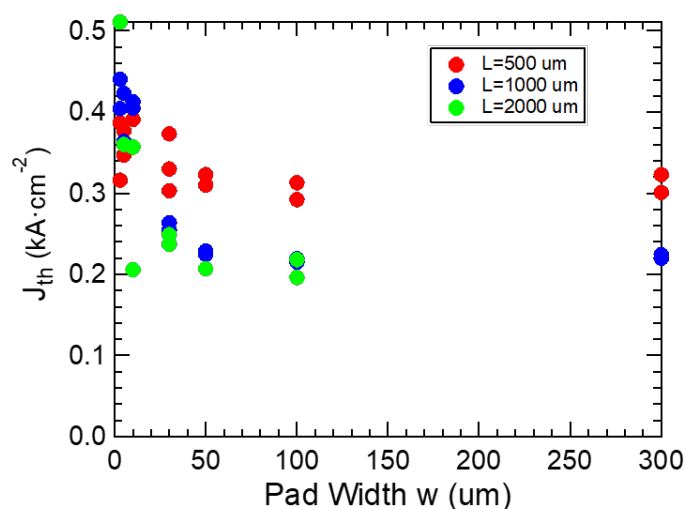


図 3.5: 3MQW の閾値電流密度

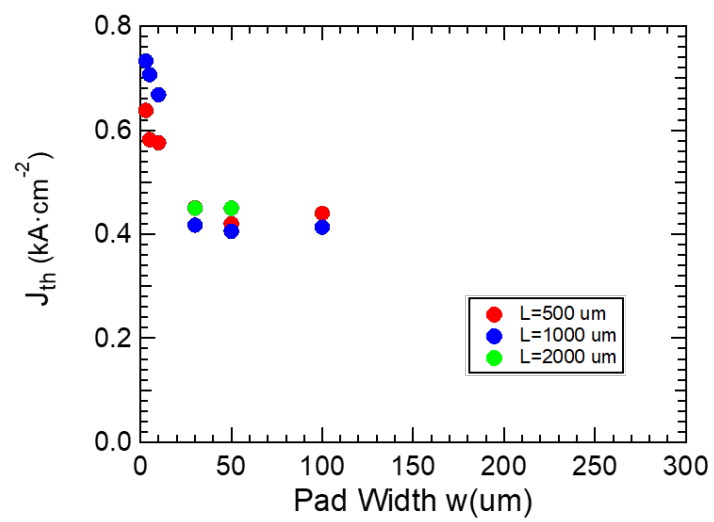


図 3.6: 10MQW の閾値電流密度

### 3.1.4 外部量子効率、内部量子効率と吸収係数の計算

次に IL カーブの発振時の傾きに相当する外部量子効率  $\Delta P/\Delta I$  から試料の内部量子効率および吸収係数を算出した。まずは外部量子効率の計算

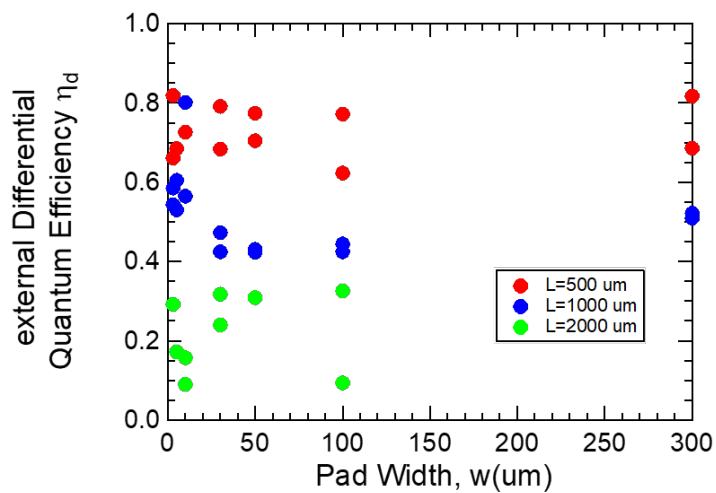


図 3.7: 3QW 外部量子効率

次に内部量子効率を見積もった代表として  $w=100\mu\text{m}$  をプロットしている。

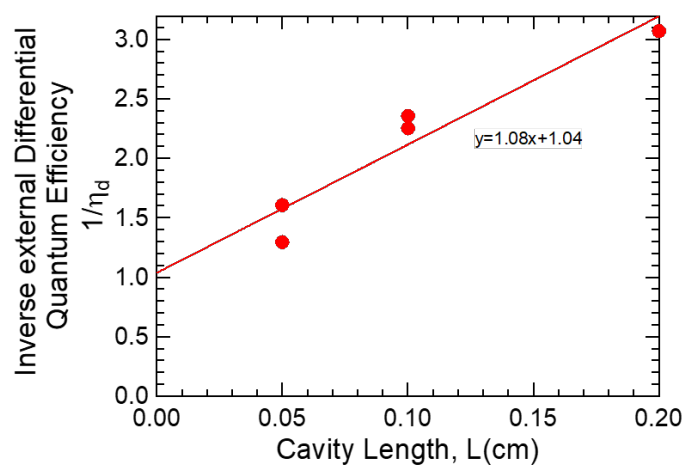


図 3.8: 3QW 外部量子効率の逆数

同様の解析を 10QW についても行った。  $w=50\mu\text{m}$

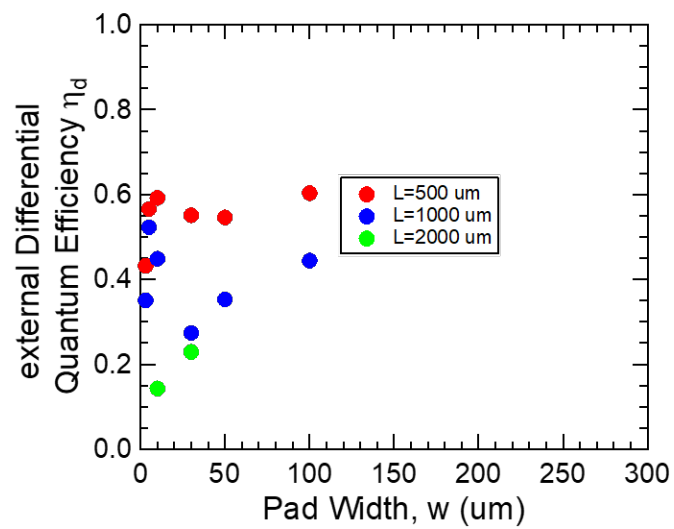


図 3.9: 10QW 外部量子効率

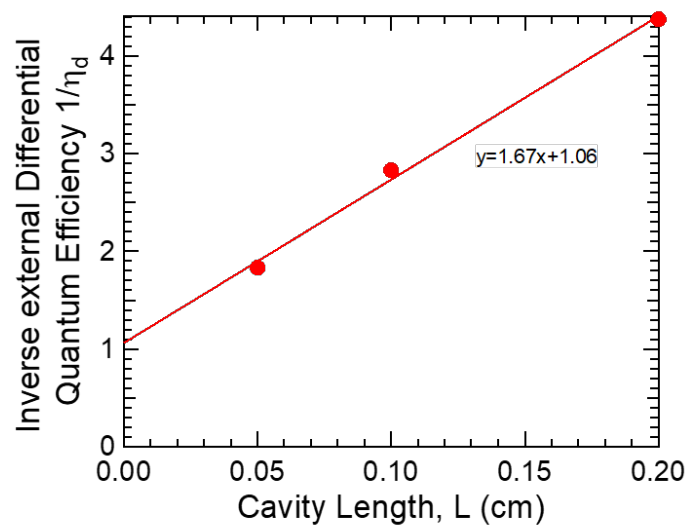


図 3.10: 10QW 外部量子効率の逆数

## 3.2 リッジ導波路型レーザーに関する実験結果

### 3.2.1 定常電流の結果

リッジ導波路型レーザーに関して電流注入利得スイッチング実験を行った。その時の光出力の時間はけいを示す。励起時間は

### 3.2.2 試料の利得スイッチング動作の結果

### 3.2.3 3QW 試料の利得スイッチング動作

$L=100,200,300$

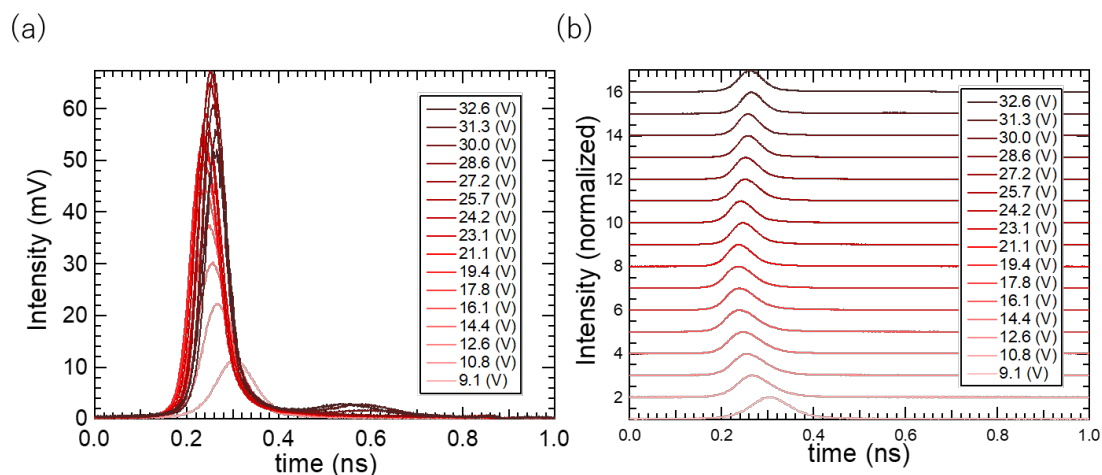


図 3.11: 3MQW  $L=100\mu\text{m}$  の利得スイッチング光パルスの時間波形

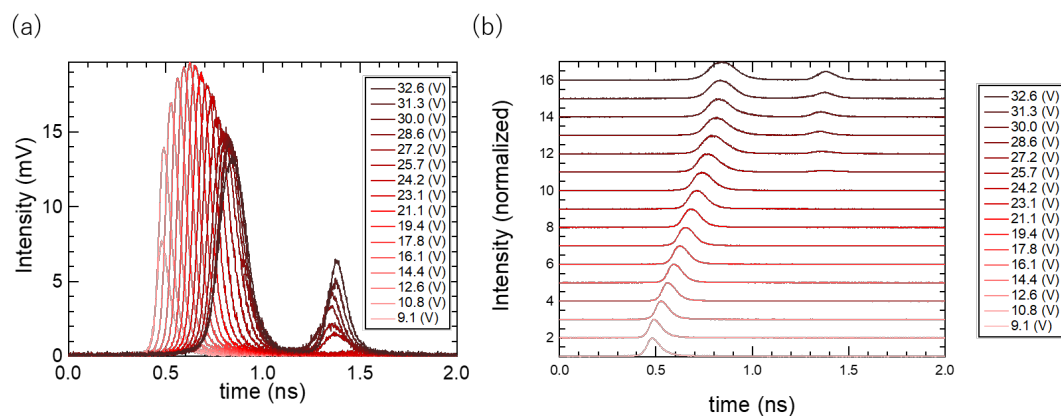


図 3.12: 3MQW  $L=200\mu\text{m}$  の利得スイッチング光パルスの時間波形

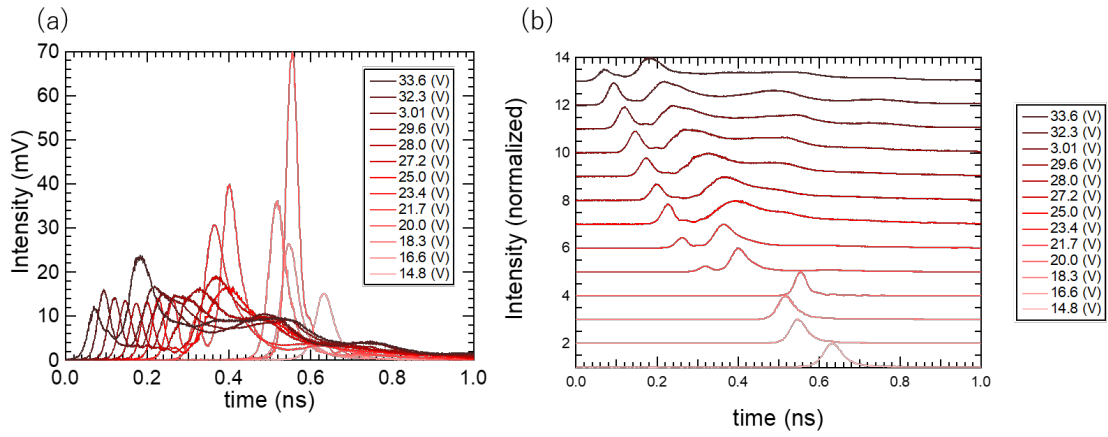


図 3.13: 3MQW  $L=300\mu\text{m}$  の利得スイッチング光パルスの時間波形

### 3.2.4 10QW 試料の利得スイッチング動作

$L=300, 400, 500$

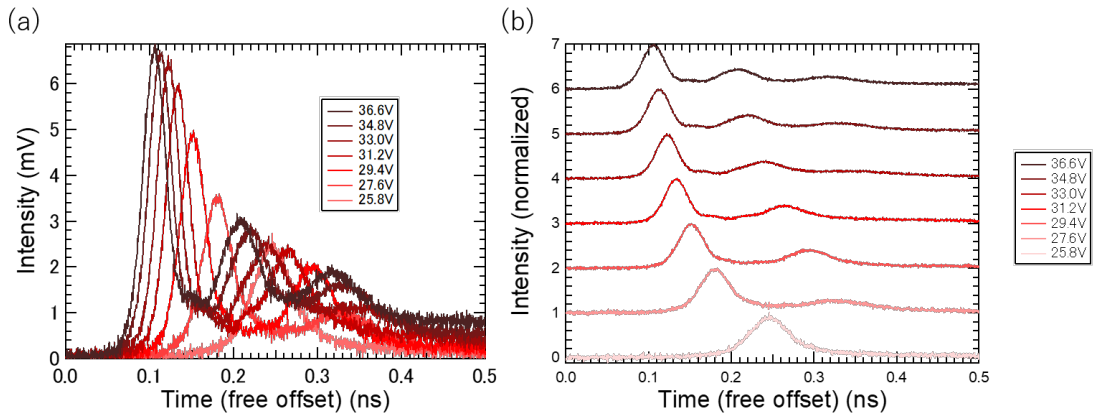


図 3.14: 10MQW  $L=300\mu\text{m}$  の利得スイッチング光パルスの時間波形

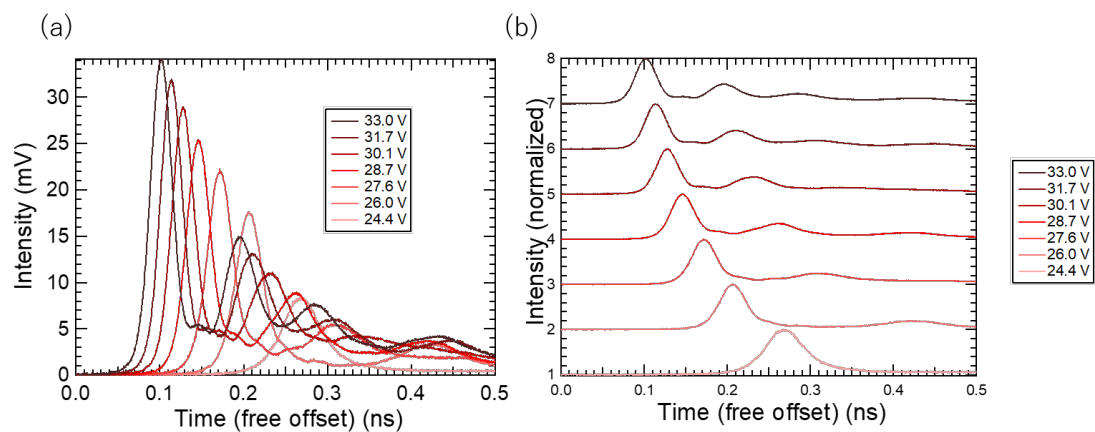


図 3.15: 10MQW  $L=400\mu\text{m}$  の利得スイッチング光パルスの時間波形

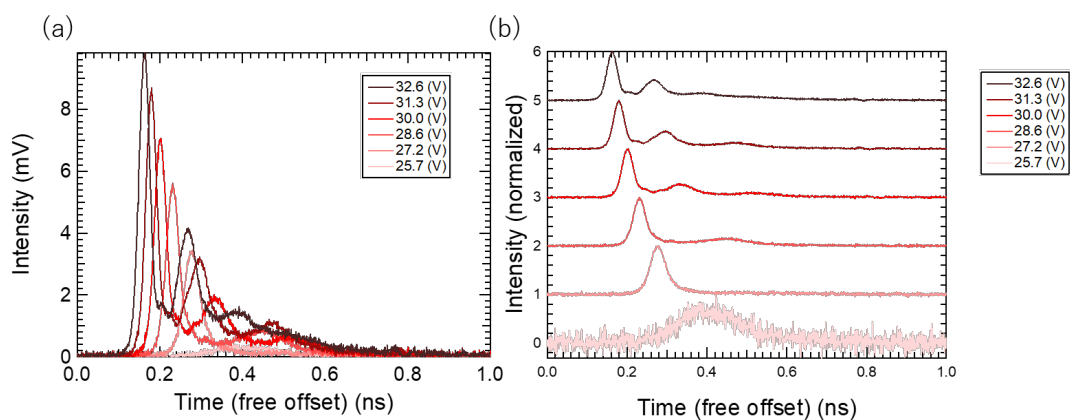


図 3.16: 10MQW  $L=500\mu\text{m}$  の利得スイッチング光パルスの時間波形



### 3.2.5 結果の比較

FWHM をまとめた。でコンボリューション後の値を示した。

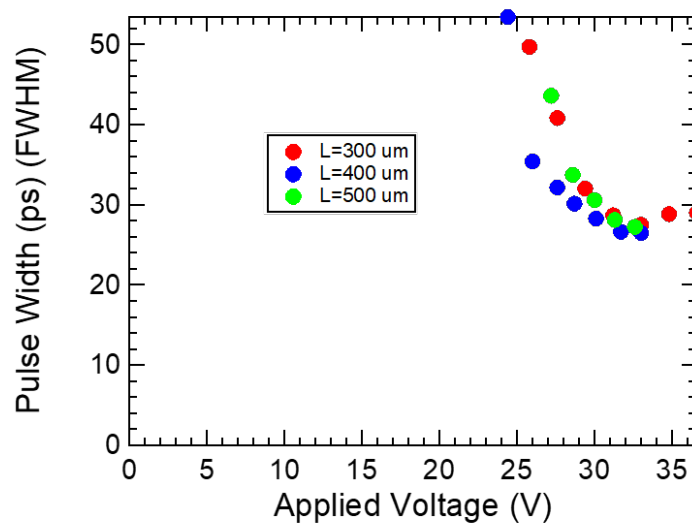


図 3.17: 10MQW 利得スイッチングパルスのパルス幅

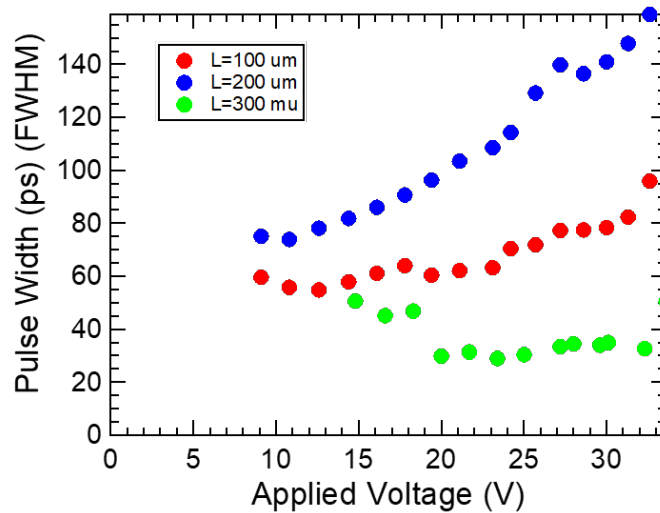


図 3.18: 3MQW 利得スイッチングパルスのパルス幅

### 3.2.6 付録かな??コンボリεύジョンの説明, 電氣パルスを確認

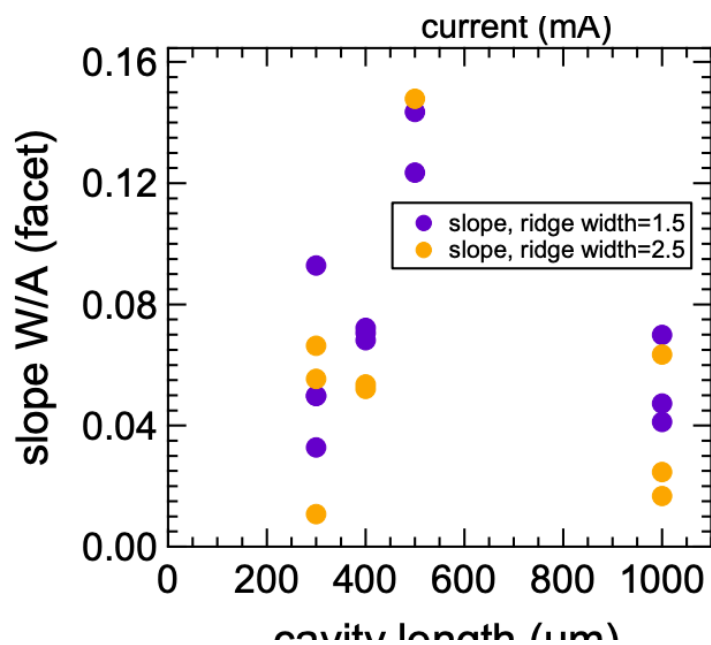


図 3.19: 10MQW のスロープ

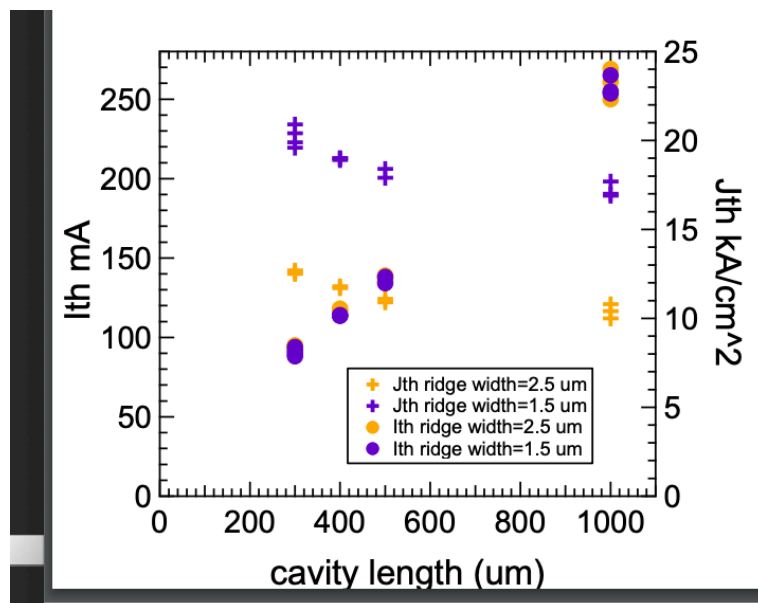


図 3.20: 10MQW の閾値電流

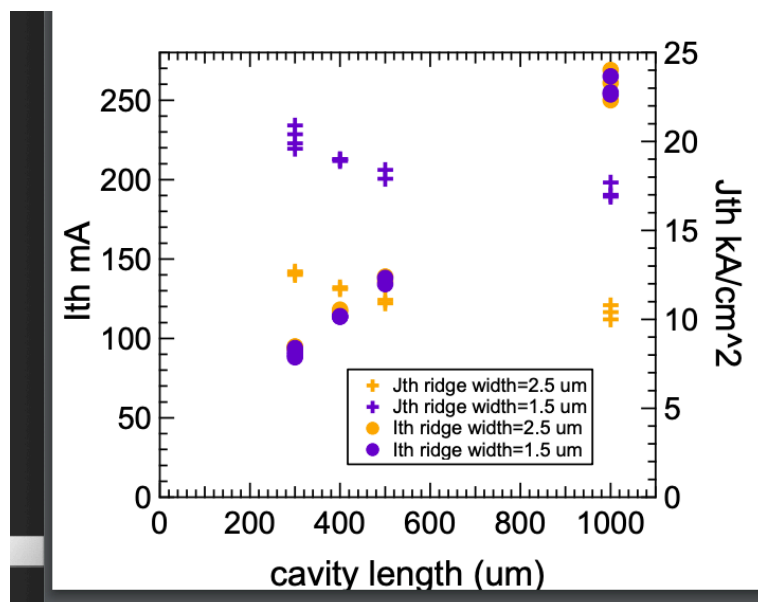


図 3.21: 10MQW の閾値電流密度のパッド幅依存性

## 第4章 考察

### 4.1 はじめに

### 4.2 パルス幅と共振器長の関係 (10QW)

### 4.3 3QW と 10QW の比較

閾値の何倍で飽和しているため利得スイッチングの速さの限界が異なる？

実験での電圧から単位体積あたりの励起強度つまり励起キャリア密度を見積もった？

## 第5章 まとめと展望

### 5.1 本研究のまとめ

### 5.2 今後の展望

あいう r を

## 関連図書

[1] reference

[2] reference

[3] reference

## 第6章 付録

### 6.1 deconvolution の計算?

### 6.2 駆動系の電気信号

謝辭